

阿部 哲郎

2008.08.28





KEKBトンネル内に設置した ARES空洞一式

デザイン・パラメータ	
Vc	0.5MV
Ra/Q0	15 Ω
Q 0	11×10^5
Pin	400kW
Pc	150kW
Us/Ua	9





ARES空洞用 高周波入力結合器



<u>KEKB運転期間中に於ける</u> <u>同軸管内マルチパクタ問題の発生</u> (2003年秋)

- KEKB運転中、使用していた32台のARES空洞の内の2台 (HER用)で真空圧力が上昇(他の空洞の3倍くらい)
- 入力パワーand/or空洞電圧を変えても改善なし
- 明確な入力パワー依存性あり
- 同軸管内で激しい放電
- コンディショニングされる傾向なし



対処

- 同軸管、及び、カップラーポートの手入れ(2003年冬)
- 入力結合器、及び、真空ポンプの交換(2004年夏)



最も問題のあった空洞(空洞M) に関しては全く改善せず

空洞内にマルチパクタを引き起こすソースがある?!

選択肢

- I. 運転は出来るので、そのまま使い続ける
 - → 時間、費用、努力はかからない
 - → 大きな事故につながる恐れあり
- II. ARES空洞一式を交換
 - → 多くの時間、費用を要する
 - → また同じことが起こらない保証はない
 - → 科学的には得られるものはない
- III. 空洞交換せず、これを研究対象とする
 - → 費用は(あまり)かからないが、時間と努力を要する
 - → 解が見つかる保証はない
 - → 科学的収穫の可能性

選択

- I. 運転は出来るので、そのまま使い続ける
 - → 時間、費用、努力はかからない
 - → 大きな事故につながる恐れあり
- II. ARES空洞一式を交換
 - → 多くの時間、費用を要する
 - → また同じことが起こらない保証はない
 - → 科学的には得られるものはない
- →III. 空洞交換せず、これを研究対象とする
 - → 費用は(あまり)かからないが、時間と努力を要する
 - → 解が見つかる保証はない
 - → 科学的収穫の可能性
 - → 空洞Mを「究極」のテストスタンドとして利用出来る

同軸管内マルチパクタ シミュレーションの開発



- ✓ マルチパクタ電子の運動方程式 を Runge-Kutta法で解く
- ✓ 電子が導体に衝突する回数を数 え、それをマルチパクタの強度と 定義





(T. Abe et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 9, 062002 (2006))







(Vc=0.54MV)

<u>マシン・スタディ</u> ● 良い真空度 右の条件を満たす新しい運転領域を <>● 放電なし ● トリップなし





<u>新しい運転ルートと領域</u>

(Vc: 0.54MV→0.68MV)



しかし、、、



「マルチパクタ問題の起こる空洞は少数」





フィードバックのターゲット領域の決定









Ⅲ. 空洞交換せず、これを研究対象とする

→費用は(あまり)かからないが、時間と努力を要する →解が見つかる保証はない

半年で解を見つける

→科学的収穫の可能性

マルチパクタ地図、及び、その運転への応用

→この空洞を「究極」のテストスタンドとして使える

<u>空洞Mに取り付けてもマルチパクタ問題の起こらない</u>

<u>入力結合器を開発する</u>



~マルチパクタの完全克服に向けて~



Fixed	
•溝の幅:	1.0 mm
•溝のピッチ:	: 2.0 mm

マルチパクタ抑制効果



溝付き実機第1号



微細溝付き入力結合器の性能試験 @テストスタンド

●4台の実機すべて、800kWまで:

≻同軸管内放電無し

▶真空度の悪化なし

微細溝付き入力結合器の性能 @<u>KEKB運転</u>

●2台の実機を、空洞M他へインストール
 >ビームなしでのエージング時 → OK
 >ビームありでの検証…

Over-coupling領域









これまでのまとめ

これから

▲SuperKEKBに向けて

- ・製作する入力結合器は溝付き
- ・現存する溝無し入力結合器を有効利用
- マルチパクタ放電が起きたら、フィードバックで一時回避。
 その後、メンテナンス時等に溝付きに交換。



Backup Slides

溝先端に於ける電場強度



ТЕМ波



ピーク値:0.565[MV/m]は、 同軸管の内導体表面に於ける 電場のピーク値:0.717[MV/m] より低い。

→溝先端辺りで十分平滑 ならば、問題なし。



Before







希硫酸

After



ARES空洞に関する 主なアップグレードR&D項目

I)より大きなDetuningに対するUs/Ua比の変更(9→15)
 →シミュレーション研究完了
 →要素試験は必要なし
 (Us: 貯蔵空洞内エネルギー)
 (Us: 貯蔵空洞内エネルギー)

Ⅱ)貯蔵空洞への新しい銅めっきの適用
 →要素試験完了
 →プロトタイプ製作完了

Ⅲ) 高次モード減衰器のアップグレード

→要素試験とデザイン(2008年度)
 →新型HOM減衰器付き加速空洞のプロトタイプ製作(2009~2010年度)

IV) 高周波入力結合器の同軸管内マルチパクタ放電の克服 →…